GAU 1754

Docket No.

214589US0/bt

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Toru YOSHIDA, et al.

GAU:

1754

SERIAL NO: 09/964,587

WASHINGTON, D.C. 20231

EXAMINER:

FILED:

September 28, 2001

ASSISTANT COMMISSIONER FOR PATENTS

FOR:

CATALYST FOR TRIMERIZATION OF ETHYLENE AND PROCESS FOR TRIMERIZING HTHYLENE

USING THE CATALYST

HEOLIA --

REQUEST FOR PRIORITY

NOV 2 0 2001

TC 1700



SIR:

- □ Full benefit of the filing date of U.S. Application Serial Number [US App No], filed [US App Dt], is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §120.
- □ Full benefit of the filing date of U.S. Provisional Application Serial Number, filed, is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119(e).
- Applicants claim any right to priority from any earlier filed applications to which they may be entitled pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119, as noted below.

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicants claim as priority:

COUNTRY

APPLICATION NUMBER

MONTH/DAY/YEAR

JAPAN

2000-302870

September 29, 2000

JAPAN

2000-374700

December 5, 2000

Certified copies of the corresponding Convention Application(s)

- are submitted herewith
- will be submitted prior to payment of the Final Fee
- were filed in prior application Serial No. filed
- were submitted to the International Bureau in PCT Application Number.

 Receipt of the certified copies by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.
- ☐ (A) Application Serial No.(s) were filed in prior application Serial No. filed; and
 - (B) Application Serial No.(s)
 - are submitted herewith
 - will be submitted prior to payment of the Final Fee

Respectfully Submitted,

OBLON, SPIVAK, McCLELLAND, MAIER & NEUSTADT, P.C.

WILLIAM E. BEAUMONT REGISTRATION NUMBER 30.996

Norman F. Oblon

Registration No.

24,618

Tel. (703) 413-3000 Fax. (703) 413-2220 (OSMMN 10/98)



日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2000年12月 5日

出 願 番 号

Application Number:

特願2000-374700

出 顏 人
Applicant(s):

東ソー株式会社

2001年10月 4日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office





特2000-374700

【書類名】 特許願

【整理番号】 PA211-0340

【提出日】 平成12年12月 5日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 C08F 4/69

【発明の名称】 エチレンの三量化触媒およびこの触媒を用いたエチレン

の三量化方法

【請求項の数】 8

【住所又は居所】 三重県桑名市新西方5-304

【氏名】 吉田 統

【発明者】

【発明者】

【住所又は居所】 三重県四日市市別名3丁目5-1

【氏名】 山本 敏秀

【発明者】

【住所又は居所】 三重県四日市市垂坂町366-1

【氏名】 岡田 久則

【発明者】

【住所又は居所】 三重県四日市市別名3丁目4-1

【氏名】 村北 栄之

【特許出願人】

【識別番号】 000003300

【氏名又は名称】 東ソー株式会社

【代表者】 田代 圓

【電話番号】 (03)5427-5134

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 003610

【納付金額】 21,000円

特2000-374700

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】

H

【書類名】 明細書

【発明の名称】 エチレンの三量化触媒およびこの触媒を用いたエチレンの三量 化方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】アミン化合物および/またはアミド化合物と、下記一般式(1) $ACrB_n$ (1)

(式中、nは1~3の整数である。Aは三脚型構造を有する中性の多座配位子であり、Crはクロム原子、Bは水素原子、ハロゲン原子、および直鎖もしくは分岐状のアルキル基からなる群より選ばれる1種以上を表す。)

で示される三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位したクロム錯体とアルキ ルアルミノキサンからなるエチレンの三量化触媒。

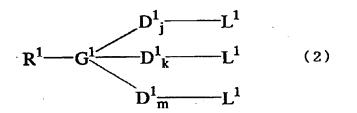
【請求項2】アミン化合物またはアミド化合物と、下記一般式(1)

$$ACrB_n$$
 (1)

(式中、nは1~3の整数である。Aは三脚型構造を有する中性の多座配位子であり、Crはクロム原子、Bは水素原子、ハロゲン原子、および直鎖もしくは分 咳状のアルキル基からなる群より選ばれる1種以上を表す。)

で示される三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位したクロム錯体とアルキルアルミノキサンとアルキル金属化合物からなるエチレンの三量化触媒。

【請求項3】三脚型構造を有する中性の多座配位子が、下記一般式(2) 【化1】

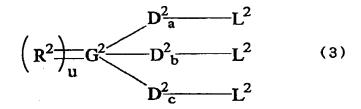


(式中、j, k, mはそれぞれ独立して $0\sim6$ の整数である。 D^1 はそれぞれ独立して置換基を有していてもよい2価の炭化水素基、 L^1 はそれぞれ独立して周期表14族、15族、16族または17族元素を含有する置換基を表す。また、 G^1 は炭素またはケイ素、 R^1 は水素原子、炭素数 $1\sim10$ のアルキル基または炭

素数6~10のアリール基を表す。)

または下記一般式(3)

【化2】

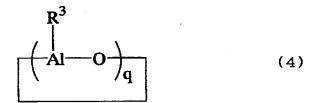


(式中、a, b, cはそれぞれ独立して $0\sim6$ の整数であり、uは0または1の整数である。 D^2 はそれぞれ独立して置換基を有していてもよい2価の炭化水素基、 L^2 はそれぞれ独立して周期表14族、15族、16族または17族元素を含有する置換基を表す。また、 G^2 は窒素原子またはリン原子、 R^2 は酸素原子またはイオウ原子を表す。)

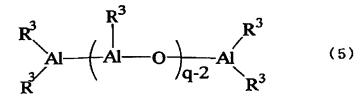
で示される三座配位子であることを特徴とする請求項1および2に記載のエチレンの三量化触媒。

【請求項4】三脚型構造を有する中性の多座配位子がfacialに配位した クロム錯体を用いることを特徴とする請求項1~3に記載のエチレンの三量化触 媒。

【請求項5】アルキルアルミノキサンが、下式(4)および/または(5) 【化3】



【化4】



(ここで、 R^3 は互いに同じでも異なっていてもよく、水素原子、または炭素数 $1\sim20$ の炭化水素基であり、qは $2\sim60$ の整数である。)

で表されることを特徴とする請求項1~4に記載のエチレンの三量化触媒。

【請求項6】アルキル金属化合物が、下記一般式(6)

$$R_{p}MX_{q}$$
 (6)

(式中、pは0<p≤3であり、qは0≤q<3であって、しかもp+qは1~3である。Mはリチウム、マグネシウム、亜鉛、ボロンまたはアルミニウムを表し、Rは炭素数1~10のアルキル基からなる群より選ばれる1種以上を表し、Xは水素原子、アルコキシド基、アリール基およびハロゲン原子からなる群より選ばれる1種以上を表す。)

で示される化合物であることを特徴とする請求項2~5に記載のエチレンの三量 化触媒。

【請求項7】アミン化合物および/またはアミド化合物が、水素以外で置換された3置換の窒素原子を1個以上有し、かつ3~30個の炭素原子を有する化合物であることを特徴とする請求項1~6に記載のエチレンの三量化触媒。

【請求項8】請求項1~7のいずれかに記載のエチレンの三量化触媒の存在下で、エチレンを三量化することを特徴とするエチレンの三量化方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、エチレンの三量化触媒およびこの触媒を用いたエチレンの三量化方法に関する。さらに詳しくは、線状低密度ポリエチレン(LLDPE)の原料コモノマーとして有用な1-ヘキセンをエチレンから効率よく、かつ高選択的に製造するエチレンの三量化触媒、およびその触媒を用いたエチレンの三量化方法に関する。

[0002]

【従来の技術】

エチレンを三量化して1-ヘキセンを得る方法において、クロム化合物を触媒 として用いることは公知である。例えば、特開昭62-265237号公報には クロム化合物、ポリヒドロカルビルアルミニウムオキシドおよびドナー配位子からなる触媒系が開示されている。特開平6-239920号公報には、クロム化合物、ピロール含有化合物、金属アルキル化合物およびハライドからなる触媒系が、また特開平8-59732号公報には、クロム化合物、金属アルキル化合物および酸アミドまたはイミド化合物からなる触媒系が開示されている。

[0003]

また、特開平6-298673号公報には、クロミウム塩の多座配位子であるホスフィン、アルシンおよび/またはスチビンとの配位錯体とアルミノキサンからなる触媒が開示されている。さらに、特開平10-7712号公報には、特定の窒素配位子が配位したクロムの塩素錯体やアルキル錯体とアルミニウム化合物からなる触媒が、特開平10-231317号公報には、環状ポリアミンまたはヒドロトリス(ピラゾリル)ボレートが配位したクロム錯体とアルキルアルミニウム化合物からなる触媒が開示されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】

しかし、特開昭62-265237号公報に記載の方法では、1-ヘキセンと 同時にポリエチレンが多く副生する欠点があった。特開平6-239920号公 報に記載の方法は、ポリエチレンの副生が少なく、この点ではかなり改善している。しかし、触媒の構成成分であるピロール含有化合物は、空気に対して極めて不安定な物質であるため着色して劣化しやすい。従って、取り扱いが難しいばかりか、反応終了後には着色成分を除去するための処理または新たな装置を必要とする等、工業的な触媒としては十分なものではなかった。また、特開平8-59732号公報に記載の方法では、触媒の構成成分である酸アミドまたはイミド化合物の化合物群の中で活性を得るには、ある特定のイミド化合物(即ちマレイミド)を用いる必要がある。マレイミドは溶解性が低いため触媒調製が煩雑であり、入手が難しいばかりか高価であり、経済性の面においても問題がある。

[0005]

一方、特開平6-298673号公報に記載の方法では、実験データの再現性 が乏しい。また、特開平10-7712号公報に記載の方法は、触媒活性が低い という問題がある。さらに、特開平10-231317号公報に記載の方法は、 ポリエチレンの生成が多いばかりか、オリゴマー中の1-ヘキセン選択性も低い という欠点がある。

[0006]

本発明は上記の課題に鑑みてなされたものであり、その目的はLLDPEの原料コモノマーとして有用な1-ヘキセンをエチレンから効率よく、かつ高選択的に製造し、しかも取り扱いの容易なエチレンの三量化触媒、およびこの触媒を用いたエチレンの三量化方法を提供することである。

[0007]

【課題を解決するための手段】

本発明者らは、上記の課題を解決するため鋭意検討を行った結果、アミン化合物および/またはアミド化合物の存在下で、特定の多座配位子が配位したクロム錯体とアルキルアルミノキサンとアルキルアルミノキサンとアルキル金属化合物からなるエチレンの三量化触媒は、安定で取り扱いが容易であり、しかもこれを用いると高い活性でエチレンの三量化反応が進行し、高選択的に1-ヘキセンが生成することを見い出し、本発明を完成するに至った

[0008]

即ち本発明は、アミン化合物および/またはアミド化合物存在下において、三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位したクロム錯体とアルキルアルミノキサン、あるいは当該クロム錯体とアルキルアルミノキサンとアルキル金属化合物を接触させてなるエチレンの三量化触媒およびそれを用いたエチレンの三量化方法に関する。

[0009]

【発明の実施の形態】

次に、本発明についてさらに詳しく説明する。

[0010]

本発明においては、エチレンの三量化触媒を構成する一成分として、下記一般 式 (1)

$$ACrB_n$$
 (1)

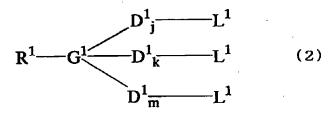
(式中、nは1~3の整数である。Aは三脚型構造を有する中性の多座配位子であり、Crはクロム原子、Bは水素原子、ハロゲン原子、および直鎖もしくは分岐状のアルキル基からなる群より選ばれる1種以上を表す。)

で示される三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位したクロム錯体が用いられる。

[0011]

ここで、クロム錯体に配位させる三脚型構造を有する中性の多座配位子として 用いられるものは特に限定されないが、例えば、下記一般式(2)

【化5】



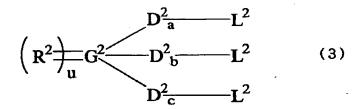
[0013]

(式中、j, k, mはそれぞれ独立して $0\sim6$ の整数である。 D^1 はそれぞれ独立して置換基を有していてもよい2価の炭化水素基、 L^1 はそれぞれ独立して周期表14族、15族、16族または17族元素を含有する置換基を表す。また、 G^1 は炭素またはケイ素、 R^1 は水素原子、炭素数 $1\sim10$ のアルキル基または炭素数 $6\sim10$ のアリール基を表す。)

または下記一般式(3)

[0014]

【化6】



[0015]

(式中、a, b, cはそれぞれ独立して $0\sim6$ の整数であり、uは0または1の整数である。 D^2 はそれぞれ独立して置換基を有していてもよい2価の炭化水素基、 L^2 はそれぞれ独立して周期表14族、15族、16族または17族元素を含有する置換基を表す。また、 G^2 は窒素原子またはリン原子、 R^2 は酸素原子またはイオウ原子を表す。)

で示される三座配位子が好適なものとして挙げられる。

[0016]

上記一般式(2) および(3) において、D¹およびD²としては特に限定されるものではないが、例えば、アルキレン基、シクロアルキレン基、フェニレン基、トリレン基、キシリレン基等が挙げられる。また、その置換基としては、例えば、メチル基、エチル基等のアルキル基類、メトキシ基、エトキシ基等のアルコキシ基類等が挙げられる。

[0017]

一般式(2)および(3)において、L¹およびL²で示される周期表14族、15族、16族または17族元素を含有する置換基は特に限定されるものではないが、例えば、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等のアルコキシ基類、フェノキシ基、2,6ージメチルフェノキシ基等のアリールオキシ基類、メチルチオ基、エチルチオ基、プロピルチオ基、ブチルチオ基等のアルキルチオ基類、フェニルチオ基、トリルチオ基等のアリールチオ基類、ジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基、ビス(トリメチルシリル)アミノ基等のジアルキルアミノ基類、ジフェニルアミノ基等のジアリールアミノ基類、メチルフェニル基等

のアルキルアリールアミノ基類、ジメチルホスフィノ基、ジエチルホスフィノ基 等のジアルキルホスフィノ基類、ジフェニルホスフィノ基、ジトリルホスフィノ 基等のジアリールホスフィノ基類、メチルフェニルホスフィノ基等のアルキルア リールホスフィノ基類が挙げられる。

[0018]

また、フリル基、ベンゾフリル基、チエニル基、ベンゾチエニル基、ピラゾリル基、トリアゾリル基、テトラゾリル基、ピリジル基、イミダゾリル基、ベンゾイミダゾリル基、インダゾリル基、キノリル基、イソキノリル基、オキサゾリル基、チアゾール基等の周期表14族、15族、16族または17族元素を含有する複素環基類が挙げられる。これらの複素環基類の環上の置換基としては、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、オクチル基、フェニル基等が挙げられる。

[0019]

一般式(2)における R^1 は特に限定されるものではないが、例えば、水素原子、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ベンジル基、ヒドロキシメチル基、シアノエチル基、アリル基、トリフルオロプロピル基等の炭素数 $1\sim10$ のアルキル基類、またはフェニル基、p-メチルフェニル基、p-クロロフェニル基等の炭素数 $6\sim10$ のアリール基類が挙げられる。

[0020]

上記一般式(2) および(3) で示される三脚型構造を有する中性の三座配位子は特に限定されるものではないが、例えば、周期表14族、15族、16族または17族元素を含有する置換基を持つ多座配位子としては、トリス(メトキシメチル)メタン、1,1,1ートリス(メトキシメチル)エタン、1,1,1ートリス(メトキシメチル)ブロパン、1,1,1ートリス(メトキシメチル)ブタン、1,1,1ートリス(エトキシメチル)エタン、1,1,1ートリス(プロポキシメチル)エタン、1,1,1ートリス(ブトキシメチル)エタン、1,1,1ートリス(フェノキシメチル)エタン等の含酸素三座配位子類、1,1,1ートリス(メチルチオメチル)エタン、1,1,1ートリス(ブチルチオメチル)エタン、1,1,1ートリス(ブチルチオメチル)エタン、1,1,1ートリス(ブチルチオメチル)エタン、1,1,1ートリス(ブチルチオメチル)エタン、1,1,1ートリス(ブェニルチオメチル)エタン等の含イオウ三

座配位子類、1,1,1-トリス(ジメチルアミノメチル) エタン、1,1,1 -トリス(ジフェニルアミノメチル) エタン等の含窒素三座配位子類、1,1, 1-トリス(ジフェニルホスフィノメチル) エタン、1,1,1-トリス(ジメ チルホスフィノメチル) エタン、1,1,1-トリス(ジエチルホスフィノメチル) エタン等の含リン三座配位子類が挙げられる。

[0021]

さらに、周期表14族、15族、16族または17族元素を含有する複素環基を持つ多座配位子としては、トリフリルメタン、トリス(5ーメチルー2ーフリル)メタン、トリス(5ープチルー2ーフリル)メタン、トリス(5ープチルー2ーフリル)メタン、トリス(5ープチルー2ーフリル)メタン、トリス(5ープチルー2ーフリル)メタン、トリフリルアミン、トリフリルホスフィン、トリフリルホスフィンオキシド等の含酸素三座配位子類、トリス(チエニル)メタン等の含イオウ三座配位子類、トリス(ピラゾリル)メタン、トリス(3,5ージメチルー1ーピラゾリル)メタン、トリス(3,5ージフェニルー1ーピラゾリル)メタン、トリス(3,5ージフェニルー1ーピラゾリル)メタン、1,1,1ートリス(3,5ージメチルー1ーピラゾリル)プロパン、1,1,1ートリス(3,5ージメチルー1ーピラゾリル)プロパン、1,1,1ートリス(3,5ージメチルー1ーピラゾリル)プタン、トリス(2ーピリジル)メタン、トリス(2ーピリジル)アミン、トリス(2ーピリジル)ホスフィン、トリス(2ーピリジル)ホスフィンオキシド、トリス(2ーピリジル)ヒドロキシメタン、トリス(1ーイミダゾリル)メタン等の含窒素三座配位子類が挙げられる。

[0022]

本発明において、上記一般式(1)のBで用いられるハロゲン原子は特に限定されるものではないが、例えば、フッ素原子、塩素原子、臭素原子またはヨウ素原子等が挙げられる。また、直鎖もしくは分岐状のアルキル基としては特に限定されるものではないが、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、シクロヘキシル基、ベンジル基またはフェニル基等が挙げられる。

[0023]

上記一般式(1)で示されるクロム錯体の具体的な例としては特に限定される

ものではないが、例えば、トリス(メトキシメチル)メタンクロムトリクロライ ド(III)、トリス(メトキシメチル)メタンクロム(ベンジル)ジクロライ ド(III)、1, 1, 1ートリス(メトキシメチル)エタンクロムトリクロラ イド(III)、1, 1, 1ートリス(エトキシメチル)エタンクロムトリクロ **ライド(III)、1, 1, 1ートリス(ブトキシメチル)エタンクロムトリク** ロライド(III)、1,1,1ートリス(フェノキシメチル)エタンクロムト リクロライド(III)、トリフリルメタンクロムトリクロライド(III)、 1, 1, 1ートリス (メチルチオメチル) エタンクロムトリクロライド (III)、1、1、1-トリス(ジメチルアミノメチル)エタンクロムトリクロライド (III)、トリス(ピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(III)、ト リス(3,5-ジメチル-1-ピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(II 、トリス(3,5ージメチルー1ーピラゾリル)メタンクロム(ヒドリド) ジクロライド(III)、トリス(3,5-ジメチル-1-ピラゾリル)メタン **クロム(ベンジル)ジクロライド(III)、トリス(3,5-ジメチル-1-**ピラゾリル) メタンクロム (エチル) ジクロライド (III) 、トリス (3, 5 ージメチルー1ーピラゾリル)メタンクロムトリベンジル(III)、1,1, 1-トリス(3,5-ジメチル-1-ピラゾリル)エタンクロムトリクロライド **(III)、トリス(3,5-ジイソプロピル-1-ピラゾリル)メタンクロム** トリクロライド(III)、トリス(3,5-ジフェニルー1ーピラゾリル)メ タンクロムトリクロライド(III)、トリス(2-ピリジル)メタンクロムト リクロライド(III)、トリス(6-メチル-2-ピリジル)メタンクロムト リクロライド(III)、トリス(2-ピリジル)アミンクロムトリクロライド (III)、トリス(1ーイミダゾリル)メタンクロムトリクロライド(III)、1,1,1ートリス(ジメチルホスフィノメチル)エタンクロムトリクロラ イド(III)、1,1,1-トリス(ジフェニルホスフィノメチル)エタンク ロムトリクロライド(III)、1,1,1ートリス(ジエチルホスフィノメチ ル)エタンクロムトリクロライド(III)等が挙げられる。

[0024]

これらのうち触媒活性の面から、一般式(1)で示される三脚型構造を有する

中性の多座配位子としては、複素環基を持つ含窒素三座配位子類が好ましく用いられ、より好ましくはトリス(3, 5-ジメチル-1-ピラゾリル)メタンが用いられる。また、Bとしてはハロゲン原子が好ましく用いられる。さらに好ましい三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位したクロム錯体としては、トリス(3, 5-ジメチル-1-ピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(III)等が用いられる。

[0025]

本発明において、上記の三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位したクロム錯体の合成法は特に限定されるものではないが、例えば、多座配位子とクロム化合物とから公知の錯体形成法 [例えば、Inorg. Chem., 25, 1080(1986)等]により容易に合成することができる。この場合、使用できるクロム化合物としては特に限定されるものではないが、例えば、塩化クロム(III)、塩化クロム(II)、臭化クロム(III)、臭化クロム(III)、コウ化クロム(III)、コウ化クロム(III)、コウ化クロム(III)、フッ化クロム(III)、フッ化クロム(III)、フッ化クロム(III)、フッ化クロム(III)、フッ化クロム(III)、フッ化クロム(III)、フッ化クロム(III)、トリス(テトラヒドロフラン)クロムトリクロライド(III)、トリス(ジエチルエーテル)クロムトリクロライド(III)、トリス(ピリジン)クロムトリクロライド(III)、トリス(アセトニトリル)クロムトリクロライド(IIII)、トリス(アセトニトリル)クロムトリクロライド(IIII)等が挙げられる。

[0026]

前記の多座配位子とクロム化合物を反応させ、クロム錯体を形成させる際のクロム金属の濃度は特に制限されない。また、ここで用いられる溶媒としては特に限定されるものではないが、有機溶媒が好ましく用いられる。例えば、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、ノナン、デカン、シクロヘキサン、デカリン等の脂肪族炭化水素類、ベンゼン、トルエン、キシレン、クメン、トリメチルベンゼン等の芳香族炭化水素類、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン等のエーテル類、塩化メチレン、クロロホルム、四塩化炭素等のハロゲン化炭化水素類が挙げられる。また、上記溶媒はそれぞれ単独で使用し得るのみならず、二種以上を混合して用いることも可能である。

[0027]

また、錯体形成反応は、-80℃から使用する反応溶媒の沸点までの任意の温度で行われ、好ましくは20~200℃である。反応溶媒の沸点以上の温度で錯形成反応を行う場合には、加圧下で行うこともできる。反応時間は特に制限されず、通常1分~48時間、好ましくは5分~24時間である。なお、反応時のすべての操作は、空気と水分を避けて行なうことが望ましい。また、原料および溶媒は十分に乾燥しておくことが好ましい。

[0028]

さらに別途合成法として、上記の方法により合成した三脚型構造を有する中性 の多座配位子が配位したクロムハロゲン錯体を原料に、アルキルアルミノキサン や金属ヒドリド化合物を溶媒中で反応させて、本発明の三脚型構造を有する中性 の多座配位子が配位したクロム錯体を合成してもよい。

[0029]

多座配位子が配位したクロム錯体は、通常固体として沈殿するので、ろ別により反応溶媒から分離できる。さらに、必要に応じて、上記溶媒を用いて洗浄を行い、次いで乾燥してエチレンの三量化触媒の構成成分の一つであるクロム錯体が合成される。なお、沈殿しない場合は、溶媒留去、貧溶媒の添加あるいは冷却処理等により沈殿させることができる。

[0030]

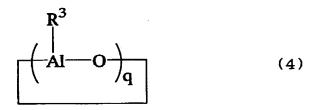
本発明においては、三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位したクロム錯体のうち、その多座配位子がfacialに配位したクロム錯体を用いることが好ましい。多座配位子がfacialに配位したクロム錯体を用いることにより、ポリエチレンの副生が抑えられる等の効果が認められる。ここで、多座配位子がfacialに配位した錯体とは、多座配位子により3つの配位座が占有された6配位八面体型錯体の異性体の一つである[化学選書 有機金属化学-基礎と応用-、143頁(裳華房)]。即ち、多座配位子により3つの配位座が占有された6配位八面体型錯体において、多座配位子により3つの配位座が占有された6配位八面体型錯体において、多座配位子が、3つの配位座が互いにシス位になるような配置で配位していることを意味する。

[0031]

本発明において使用されるアルキルアルミノキサンは特に限定されるものではないが、下記一般式(4)および/または(5)

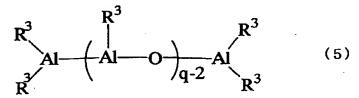
[0032]

【化7】



[0033]

【化8】



[0034]

(ここで、 R^3 は互いに同じでも異なっていてもよく、水素原子、または炭素数 $1\sim20$ の炭化水素基であり、qは $2\sim60$ の整数である。)

で表される、アルミニウムと酸素の結合を有するアルミニウムオキシ化合物である。一般式 (4) および (5) において、R³は各々同一でも異なっていてもよい。R³は、例えば、水素原子、またはメチル基、エチル基、プロピル基、nーブチル基、イソブチル基、tertーブチル基などで表すことができる炭素数1~20の炭化水素基である。また、qは2~60の整数である。用いられるアルキルアルミノキサンの使用量は、クロム錯体1モルに対してアルミニウムが0.1~10000当量であり、好ましくは0.5~8000当量、より好ましくは1~5000当量である。

[0035]

本発明において使用されるアルキル金属化合物は特に限定されるものではないが、例えば、下記一般式(6)

 $R_{\mathbf{p}}MX_{\mathbf{q}}$ (6)

(式中、pは0 であり、<math>qは $0 \le q < 3$ であって、しかもp + qは $1 \sim 3$ である。Mはリチウム、マグネシウム、亜鉛、ボロンまたはアルミニウムを表し、Rは炭素数 $1 \sim 1$ 0のアルキル基からなる群より選ばれる1種以上を表し、Xは水素原子、アルコキシド基、アリール基およびハロゲン原子からなる群より選ばれる1種以上を表す。)

で示される化合物が好適なものとして挙げられる。

[0036]

上記一般式(6)において、炭素数1~10のアルキル基は特に限定されるものではないが、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、シクロヘキシル基またはオクチル基等が挙げられる。アルコキシド基としては特に限定されるものではないが、例えば、メトキシド基、エトキシド基、ブトキシド基またはフェノキシド基等が挙げられる。アリール基としては特に限定されるものではないが、例えば、フェニル基等が挙げられる。ハロゲン原子としては特に限定されるものではないが、例えば、フッ素、塩素、臭素またはヨウ素が挙げられる。

[0037]

なお、上記一般式(6)において、MがA1で、pとqがそれぞれ1.5のとき、A1R $_{1.5}$ X $_{1.5}$ となる。このような化合物は、理論的には存在しないが、通常、慣用的にA1 $_2$ R $_3$ X $_3$ のセスキ体として表現されており、これらの化合物も本発明に含まれる。

[0038]

上記一般式(6)で示されるアルキル金属化合物としては、例えば、メチルリチウム、エチルリチウム、プロピルリチウム、n-ブチルリチウム、sec-ブチルリチウム、tert-ブチルリチウム、ジエチルマグネシウム、エチルブチルマグネシウム、エチルクロロマグネシウム、エチルブロモマグネシウム、ジメチル亜鉛、ジエチル亜鉛、ジブチル亜鉛、トリメチルボラン、トリエチルボラン、トリメチルアルミニウム、トリエチルアルミニウム、トリイソブチルアルミニウム、トリーn-ヘキシルアルミニウム、ドリーn-オクチルアルミニウム、トリシクロヘキシルアルミニウム、ジメチルエチ

ルアルミニウム、ジエチルアルミニウムヒドリド、ジイソブチルアルミニウムヒ ドリド、ジエチルアルミニウムエトキシド、ジエチルアルミニウムフェノキシド 、ジシクロヘキシルフェニルアルミニウム、エチルアルミニウムエトキシクロリ ド、ジエチルアルミニウムクロリド、ジエチルアルミニウムブロミド、ジイソブ チルアルミニウムクロリド、ジシクロヘキシルアルミニウムクロリド、メチルア ルミニウムセスキクロリド、エチルアルミニウムセスキクロリド、ブチルアルミ ニウムセスキクロリド、エチルアルミニウムジクロリド、イソブチルアルミニウ ムジクロリド等が挙げられる。これらのうち入手の容易さおよび活性の面から、 トリアルキルアルミニウム化合物が好ましく用いられ、さらに好ましくはトリメ チルアルミニウム、トリエチルアルミニウム、トリイソブチルアルミニウム、ト リーn-ブチルアルミニウム、トリーn-ヘキシルアルミニウムまたはトリーn ーオクチルアルミニウムが用いられる。これらのアルキル金属化合物は単独で使 用し得るのみならず、二種以上を混合して用いることも可能である。用いられる アルキル金属化合物の使用量は、クロム錯体1モルに対して0.1~10000 当量であり、好ましくは3~3000当量、より好ましくは5~2000当量で ある。

[0039]

本発明において用いられるアミン化合物およびアミド化合物は特に限定されるものではないが、水素以外の3置換の窒素原子を1個以上有し、3~30個の炭素原子を有する化合物が好適なものとして挙げられる。具体的には、特に限定されるものではないが、トリメチルアミン、トリエチルアミン、1,4ージアザビシクロ [2.2.2] オクタン(DABCO)、N-メチルインドール、N-エチルインドール、N-エチルインドール、N-メチルマレイミド、N-エチルマレイミド、N-カロピルマレイミド、N-イソプロピルマレイミド、N-シクロへキシルマレイミド、N-フェニルマレイミド、N-ピレニルマレイミド、N-tertーブチルマレイミド、2,6ージメチルピリジン、N-メチルアジリジン、4-(N,N-ジメチルアミノ)ピリジン(DMAP)、1,8ーピス(N,N-ジメチルアミノ)ナフタレン(Proton Sponge)、N-メチルピロール、3,5ージメチルーN-メチルピロール、1,5ージアザビシクロ [4.3.0]

ノネン-5 (DBN)、1,8-ジアザビシクロ[5.4.0]ウンデセン-7 (DBU)、N-フェニルピロール、N-エチルピロール、5,10,15,20-テトラフェニルー21H,23H-ポルフィン、21H,23H-ポルフィン、2,3,7,8,12,13,17,18-オクタエチルー21H,23H-ポルフィン、29H,31H-フタロシアニン等が挙げられ、好ましくは上記のマレイミド類、ピリジン類、および橋頭構造を有するアミン類が挙げられる。さらに、これらのアミン化合物およびアミド化合物は単独のみならず、二種以上を用いることも可能であり、その使用量はクロム錯体に対して0.1~10000等量であり、好ましくは1~5000等量であり、また3~100等量用いたとき高い触媒活性を発現するため、より好ましい。

[0040]

本発明の三量化触媒は、アミン化合物および/またはアミド化合物の存在下において、クロム錯体とアルキルアルミノキサン、さらに必要に応じてアルキル金属化合物を原料に、溶媒中で接触させることにより調製できる。接触方法は特に制限されない。

[0041]

この触媒を調製する際のクロム錯体の濃度は特に制限されないが、通常、溶媒 11あたり0.001マイクロモル~100ミリモル、好ましくは0.01マイクロモル~10ミリモルの濃度で使用される。0.001マイクロモルより小さい触媒濃度では十分な活性が得られず、逆に100ミリモルより大きい触媒濃度では触媒活性が増加せず経済的でない。また、ここで用いられる溶媒としては、例えば、ブタン、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、イソオクタン、ノナン、デカン、シクロペンタン、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、シクロオクタン、デカリン等の脂肪族炭化水素類、ベンゼン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、クメン、トリメチルベンゼン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼン等の芳香族炭化水素類および塩化メチレン、クロロホルム、四塩化炭素、ジクロロエタン等の塩素化炭化水素類が挙げられる。また、反応生成物、即ち、1ーヘキセンを溶媒として用いることもできる。これらの溶媒は、それぞれ単独で使用し得るのみならず、二種以上を混合して用いることも可能である。ここで、

エチレンの三量化反応時のクロム錯体濃度をコントロールする目的で、必要に応 じて濃縮や希釈しても差し支えない。

[0042]

また、アミン化合物および/またはアミド化合物の存在下において、前記のクロム錯体とアルキルアルミノキサン、あるいは当該クロム錯体とアルキルアルミノキサンとアルキル金属化合物を接触させる際の温度は−100~250℃、好ましくは0~200℃である。接触時間は特に制限されず、1分~24時間、好ましくは2分~2時間である。なお、接触時のすべての操作は、空気と水分を避けて行なうことが望ましい。また、原料および溶媒は十分に乾燥しておくことが好ましい。

[0043]

本発明のエチレンの三量化反応は、アミン化合物および/またはアミド化合物の存在下において、前記のクロム錯体とアルキルアルミノキサン、あるいは当該クロム錯体とアルキルアルミノキサンとアルキル金属化合物からなる触媒とエチレンを接触させることにより行うことができる。接触方法は特に制限されないが、例えば、三量化反応の原料であるエチレンの存在下に、アミン化合物および/またはアミド化合物とクロム錯体とアルキルアルミノキサン、あるいはアミン化合物および/またはアミド化合物とクロム錯体とアルキルアルミノキサンとアルキル金属化合物を接触させて、接触と同時に三量化反応を開始する方法が例示され、また、アミン化合物および/またはアミド化合物とクロム錯体とアルキルアルミノキサン、あるいはアミン化合物および/またはアミド化合物とクロム錯体とアルキルアルミノキサンとアルキル金属化合物を前もって接触させた後、エチレンと接触させて三量化反応を行う方法が例示される。なお、これらの混合順序は特に制限されない。

[0044]

本発明におけるエチレンの三量化反応の温度は、-100~250℃であるが、好ましくは0~200℃である。反応圧力は、反応系がエチレン雰囲気であれば特に制限されないが、通常、絶対圧で0.01~3000kg/cm²であり、好ましくは0.1~300kg/cm²である。また、反応時間は、5秒~6

時間である。また、エチレンは、前記の圧力を保つように連続的に供給してもよいし、反応開始時に前記圧力で封入して反応させてもよい。原料ガスであるエチレンには、反応に不活性なガス、例えば、窒素、アルゴン、ヘリウム等が含まれていても何ら差し支えない。なお、エチレン三量化反応のすべての操作は、空気と水分を避けて行うことが望ましい。また、エチレンは十分に乾燥しておくことが好ましい。

[0045]

本発明におけるエチレンの三量化反応は、回分式、半回分式、連続式のいずれでも実施できる。エチレンの三量化反応終了後、反応液に、例えば、水、アルコール、水酸化ナトリウム水溶液等の失活剤を添加して反応を停止させることができる。失活した廃クロム触媒は公知の脱灰処理方法、例えば、水またはアルカリ水溶液による抽出等で除去できる。生成した1-ヘキセンは、公知の抽出法や蒸留法により反応液より分離される。また、副生するポリエチレンは、反応液出口で公知の遠心分離法や1-ヘキセンを蒸留分離する際の残渣として分離除去することができる。

[0046]

【実施例】

以下に、本発明を実施例によりさらに詳細に説明するが、これらの実施例は本 発明の概要を示すもので、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。

[0047]

IR測定:

IRは、島津製作所製 赤外分光光度計 (FTIR-8100) を用いて、ヌジョール法で測定した。

[0048]

ガスクロマトグラフィーによる分析:

反応液中に含まれる炭素数4~8の生成物の定量は、GLサイエンス製 TC -1のカラムを装着した島津製作所製 ガスクロマトグラフ (GC-14A)を 用いて分析した。分析条件は、窒素キャリアを用い、インジェクション温度28.0℃、検出器温度280℃に設定し、内部標準としてn-ヘプタンを用いた。分

析は、このガスクロマトグラフに反応液を1.2 μ 1 注入した後、カラムの温度を40℃から250℃まで昇温することにより行った。

[0049]

また、炭素数10以上の生成物は、上記ガスクロマトグラフとは別途用意した GLサイエンス製 TC-1のカラムを装着した島津製作所製 ガスクロマトグラフ (GC-14A)を用いて分析した。分析条件は、窒素キャリアを用い、インジェクション温度300℃、検出器温度300℃に設定し、内部標準として n-ヘプタンを用いた。分析は、このガスクロマトグラフに反応液を1.4μ1注入した後、カラムの温度を50℃から300℃まで昇温することにより行った。

[0050]

気体中に含まれる生成物は、クロムパック製 Al₂O₃/KClのカラムを装着した島津製作所製 ガスクロマトグラフ (GC-9A) を用いて分析した。分析条件は、窒素キャリアを用い、インジェクション温度200℃、検出器温度200℃およびカラム温度120℃に設定し、絶対検量線法を用いた。分析は、このガスクロマトグラフに回収した気体を0.2ml注入することにより行った。

[0051]

参考例1

内容積100m1のシュレンク管に、J. Amer. Chem. Soc., 9 2, 5118 (1970) に記載の方法で合成した三脚型構造を有するトリス(3, 5ージメチルー1ーピラゾリル) メタン 126mg、トリス(テトラヒドロフラン) クロムトリクロライド(III) 143mg、テトラヒドロフラン20m1を加え、窒素雰囲気下で12時間攪拌した。生成した結晶をろ別し、トリス(3, 5ージメチルー1ーピラゾリル) メタンクロムトリクロライド(III) を得た(IR(ヌジョール):1565cm⁻¹)。以下、この錯体を錯体Aと称する。

[0052]

比較例1~2

温度計および攪拌装置を備えた内容積300mlのステンレス製耐圧反応容器 に、窒素下で、参考例1で合成した錯体Aとトルエンを60ml入れ、混合撹拌 した。撹拌速度を1000rpmに調整後、さらにメチルアルミノキサンまたはメチルアルミノキサンとトリnーオクチルアルミニウムを入れ、30分後反応容器を80℃に加熱し、反応容器内の圧力を40kg/cm²となるようにエチレンガスを吹き込み、エチレンの三量化反応を開始した。以後、前記圧力を維持するように導入し続け、これらの反応条件を保った状態で30分反応を行なった。その後、反応容器中に水を窒素で圧入することにより触媒を失活させて反応を停止した。

[0053]

反応容器を室温まで冷却し、次いで脱圧した。反応液および回収した気体中に 含まれる生成物をガスクロマトグラフィーにより分析した。結果を表1に示す。

[0054]

実施例1~2

温度計および攪拌装置を備えた内容積300mlのステンレス製耐圧反応容器に、窒素下で、参考例1で合成した錯体AとN-フェニルマレイミドとトルエンを60ml加えた後、アルキルアルミノキサンまたはアルキルアルミノキサンとアルキル金属化合物を入れ、混合撹拌した。

[0055]

反応容器を80℃に加熱し、撹拌速度を1000rpmに調整後、反応容器内の圧力を40kg/cm²となるようにエチレンガスを吹き込み、エチレンの三量化反応を開始した。以後、前記圧力を維持するように導入し続け、これらの反応条件を保った状態で30分反応を行なった。その後、反応容器中に水を窒素で圧入することにより触媒を失活させて反応を停止した。

[0056]

反応容器を室温まで冷却し、次いで脱圧した。反応液および回収した気体中に 含まれる生成物をガスクロマトグラフィーにより分析した。結果を表1に示す。 [0057]

【表1】

	α-神魔(+3)	*	66	9.8	99.9	9.6	
	ペーを	*		8	6	6	
	₩ WEE	1 C8 11 F	12.5	7.4	111	8.8	
	オリコマー分率 [wd6]	8	87.2	92,3	88.6	90,7	
i	オリコ	8	0.3	0.3	0.3	0.4	
	一之,に/, 4/一之/, 4	3/3	1.2	2.1	1.7	2.0	・リーnーオクチルアルミニクム(使用、(+3X34ナリゴマー中の1 - ~ +3X035moV/沿液を9.8mは用、(+8X1.174mmoV/沿液を6.2ml的 (40kg/cm2), 80°C、30分、幾半速度(1000mn)
	1 - ヘキセン活性	[4/上粒媒溶液/h]	51.4	81,2	70.0	68,2	
		kg/g-C/h	20,7	24.5	282	27.5	
	ルアルミノキサン(*1) アルキル金属化合物*2)	はい○モル む	180(*4)	なし	180(*4)	なし	
	ፖルキ	はなまかせ	(\$*)081	(9+)098 .	180(45)	380(48)	
エチレン3人化反応の結果	ボアイを介にする一へ	(別/のモル比)	JE	なし	5	5	(*1)メチルアルミノキサン便用(*2)) (*42)334/mmol/1浴液を1.8mt使用.(反広条件: 触媒A(3 kmol)、エチレン
数1. エチレ	安原衛島		上4交例1	比較例2	实施例1	実施例と	(*1)メチルア (*42)334mm 反応発(特: f)

[0058]

【発明の効果】

本発明によれば、アミン化合物および/またはアミド化合物と、三脚型構造を 有する中性の多座配位子が配位したクロム錯体とアルキルアルミノキサン、ある いは当該クロム錯体とアルキルアルミノキサンとアルキル金属化合物からなるエ チレンの三量化触媒は、安定で取り扱いが容易であり、しかもこれを用いるとエ チレンから効率よく、かつ高選択的に1-ヘキセンを製造することができる。 【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 エチレンから効率よく、かつ高選択的に1-ヘキセンを製造する。

【解決手段】 アミン化合物および/またはアミド化合物と、下式(1)

 $ACrB_n$ (1)

(式中、nは1~3の整数である。Aは三脚型構造を有する中性の多座配位子であり、Crはクロム原子、Bは水素原子、ハロゲン原子、および直鎖もしくは分岐状のアルキル基からなる群より選ばれる1種以上を表す。)

で示される三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位したクロム錯体とアルキルアルミノキサン、あるいは当該クロム錯体とアルキルアルミノキサンとアルキル金属化合物からなる触媒を用いる。

【選択図】 選択図なし

特2000-374700

出願人履歴情報

識別番号

[000003300]

1. 変更年月日

1990年12月 2日

[変更理由]

住所変更

住 所

山口県新南陽市開成町4560番地

氏 名

東ソー株式会社